

抛光液

JESINE
洁芯半导体
JESINE SEMICONDUCTOR

Wafer CMP Slurry

高质量晶圆抛光液



碳化硅抛光

定制研发生产

衬底晶圆抛光液

第一代



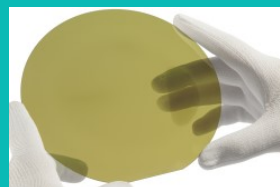
Si Ga

第二代



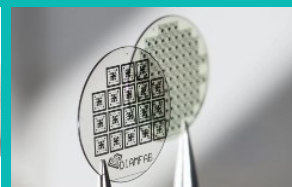
*GaAs InP
LT LN*

第三代



*SiC
GaN*

第四代

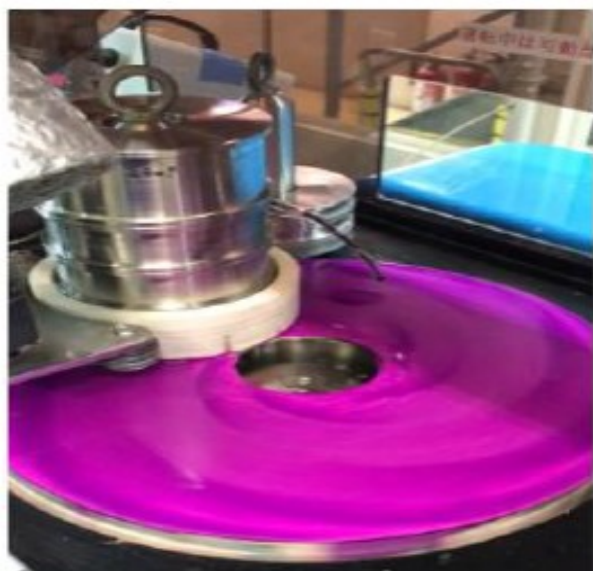


*Ga₂O₃
Diamond*

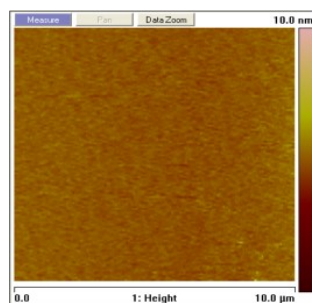
产品系列

对象工艺	名称	对象研磨	磨料	缓冲液
前段工艺	Cu/Ta	铜	二氧化硅	过氧化氢
	Cu/Ta/TEOS	钽	二氧化硅	过氧化氢
	W	钨	二氧化硅	过氧化氢
	SiNx	氧化硅	氧化铈	pH3-8
TSV	Cu	铜	二氧化硅	过氧化氢
	Si/Cu/Ta/TEOS	硅	二氧化硅	过氧化氢
	Si/SiN/TEOS	硅/氧化硅	二氧化硅/氧化铈	氢氧化钠/氨
	Cu/塑料	聚合物	二氧化硅	中性
SiC	SiC	碳化硅	氧化铝	高锰酸钾
HDD head	AlTiC	AlTiC	金刚石	油基

加工案例

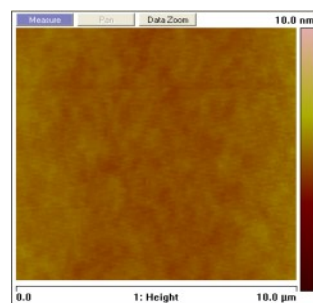


◆抛光后(Si面)



Ra: 0.078nm
测试范围: 10×10μm

◆抛光后(C面)



Ra: 0.14nm
测试范围: 10×10μm

抛光结果

- 抛光后表面粗糙度
(Ra Si面 0.078nm, C面0.14nm)
- 碳化硅高速抛光
(Si面 2.1μm/h, C面 5.0μm/h)

